COMPOSITION FOR OFTICAL MATERIAL, OPTICAL MATERIAL, ITS MANUFACTURING METHOD, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIGHT-EMITTING DIODE OBTAINED USING THE SAME

Patent Number:

JP2002338833

Publication date:

2002-11-27

Inventor(s):

OUCHI KATSUYA; TSUMURA MANABU; SAKAMOTO HARUMI; FUJITA MASAYUKI; KURAMOTO

MASAFUMI; MIKI MICHIHIDE

Applicant(s):

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD;; NICHIA CHEM IND LTD

Requested Patent: JP2002338833

Application

Number:

JP20020044708 20020221

Priority Number

IPC Classification: C08L101/02; C08K5/5415; C08K5/5435; C08L47/00; G02B1/04; H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composition for an optical material hardly undergoing photodeterioration, having a small linear expansion coefficient and exhibiting a high optical transparency, an optical material, its manufacturing method, and a liquid crystal display device and a light-emitting diode each obtained using the same. SOLUTION: The composition for an optical material comprises as essential ingredients (A) an organic compound bearing in one molecule at least two carbon-carbon double bonds reactive with an SiH group, (B) a silicon compound bearing in one molecule at least two SiH groups, (C) a hydrosilylation catalyst, (D) a compound bearing in one molecule at least two hydrolyzable groups bonded to a metal atom and/or a semi-metal atom, and/or a partial condensate thereof, and (E) water and/or a water-generating compound.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-338833 (P2002-338833A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 8 L 101/02	•	C 0 8 L 101/02	[4 J 0 0 2
C 0 8 K 5/5415		C 0 8 K 5/5415	5 F O 4 1
5/5435		5/5435	·
C08L 47/00	٠	C08L 47/00	•
G 0 2 B 1/04		G02B 1/04	
•		審査請求 未請求 請求項の数29	OL (全 23 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2002-44708(P2002-44708)

(22)出願日 平成14年2月21日(2002.2.21)

(31) 優先権主張番号 特願2001-48549 (P2001-48549) (32) 優先日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

(74)上記1名の代理人 100086586

弁理士 安富 康男 (外1名)

(71)出顧人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(74)上記1名の代理人 100086586

弁理士 安富 康男

(72)発明者 大内 克哉

大阪府摂津市鳥飼西5丁目5-35-505

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学材料用組成物、光学材料、その製造方法、並びにそれを用いた液晶表示装置および発光ダイオード

(57)【要約】

【課題】 光劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さら に光学的透明性が高い、光学材料用組成物、光学材料、 その製造方法、並びにそれを用いた液晶表示装置及び発 光ダイオードを提供することである。

【解決手段】 (A) Si H基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基を含有するケイ素化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、

(D)金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を必須成分として光学材料用組成物とすること。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機 化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSiH基を 含有するケイ素化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、

(D)金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分 解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及 び/又は、その部分縮合物、並びに(E) 水及び/又は 水を生成する化合物を必須成分として含有することを特 徴とする光学材料用組成物。

【請求項2】 (A)成分が、SiH基と反応性を有す るビニル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化 合物であることを特徴とする請求項1記載の光学材料用 組成物。

【請求項3】 (A)成分が、SiH基と反応性を有す るアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化 合物であることを特徴とする請求項 1 記載の光学材料用 組成物。

【請求項4】 (A)成分が、1,2-ポリブタシエ ン、ビニルシクロヘキセン、シクロベンタジエン、ジシ 20 を含有するケイ素化合物、(C)ヒトロシリル化触媒、 クロペンタジェン、ジビニルビフェニル、またはピスフ ェノールAジアリルエーテルであることを特徴とする請 求項1記載の光学材料用組成物。

(A)成分が、トリアリルイソシアヌレ 【請求項5】 ート、またはトリビニルシクロヘキサンであることを特 徴とする請求項 1 記載の光学材料用組成物。

【請求項6】 さらに(F)縮合触媒を必須成分として 含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一 項に記載の光学材料用組成物。

【請求項7】 (F)縮合触媒がTi系縮合触媒である 30 ことを特徴とする請求項6記載の光学材料用組成物。

【請求項8】 (D)成分の金属原子が、A1、Zn、 Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrからな る群より選ばれる一種あるいは複数の原子であり、半金 属原子がB及び/又はSiであることを特徴とする請求 項1乃至7のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項9】 (D)成分の加水分解性基が、アルコキ シ基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基から なる群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを 特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の光学 40 材料用組成物。

【請求項10】 光学材料が液晶用フィルムである請求 項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項11】 光学材料が液晶用プラスチックセルで ある請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用 組成物。

【請求項12】 光学材料が発光ダイオードの封止材で ある請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用 組成物。

【請求項13】 請求項1乃至12のいずれか一項に記 50 n、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrか

載の光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中の SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合とSiH 基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半 金属原子に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応さ せることによって硬化させてなる光学材料。

【請求項14】 請求項1乃至12にいずれか一項に記 載の光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中の SiH基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合とSiH 基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半 金属原子に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応さ せることによる、請求項13に記載の光学材料を製造す る方法。

【請求項15】 請求項13に記載の光学材料を用いた 液晶表示装置。

【請求項16】 請求項13に記載の光学材料を用いた 発光ダイオード。

【請求項17】 (A)SiH基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSiH基

(D)金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分 解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及 び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は 水を生成する化合物を必須成分として含有する硬化性組 成物を用いて発光素子が被覆された発光ダイオード。

【請求項18】 (A)成分は、SiH基と反応性を有 するビニル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機 化合物であることを特徴とする請求項17記載の発光ダ イオード。

【請求項19】 (A)成分は、SiH基と反応性を有 するアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機 化合物であることを特徴と請求項17記載の発光ダイオ ード。

【請求項20】 (A) 成分は、1,2-ポリブタジエ ン、ビニルシクロヘキセン、シクロベンタジェン、ジシ クロペンタジエン、ジビニルビフェニル、またはビスフ ェノールAジアリルエーテルであることを特徴とする請 求項17記載の発光ダイオード。

(A)成分は、トリアリルイソシアヌ 【請求項21】 レート、またはトリビニルシクロヘキサンであることを 特徴とする請求項17記載の発光ダイオード。

【請求項22】 前記硬化性組成物は、さらに(F)縮 合触媒を必須成分として含有することを特徴とする請求 項17乃至21のいずれか一項に記載の発光ダイオー ۴.

(F)縮合触媒は、Ti系縮合触媒で 【請求項23】 あることを特徴とする請求項22に記載の発光ダイオー ۴.

(D)成分の金属原子は、A1、Z 【請求項24】

らなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子であり、 半金属原子は、B及び/又はSiであることを特徴とす る請求項17乃至23のいずれか一項に記載の発光ダイ

【請求項25】 (D)成分の加水分解基は、アルコキ シ基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基から なる群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを 特徴とする請求項17乃至24のいずれかに記載の発光

【請求項26】 前記硬化性組成物は、前記発光素子を 10 被覆する前にあらかじめ混合されて組成物中のSiH基 と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合とSi H基の一部 または全部が反応し金属原子及び/又は半金属原子に結 合した加水分解性基が加水分解縮合反応しているととを 特徴とする請求項17乃至25のいずれか一項に記載の 発光ダイオード。

【請求項27】 前記発光素子は、珪素を含有する無機 化合物層を表面に有し、前記無機化合物層に接して、前 記硬化性組成物から得られる透光性封止材が設けられて いることを特徴とする請求項17乃至26のいずれか― 項に記載の発光ダイオード。

【請求項28】 前記無機化合物層は、前記発光素子か ら発光される光の少なくとも一部を吸収して他の波長を 有する光を発光することが可能な蛍光物質を有すること を特徴とする請求項27記載の発光ダイオード。

【請求項29】 (A)SiH基と反応性を有する炭素 -炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 機化合物、(B)1分子中に少なくとも2個のSiH基 を含有するケイ素化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、

(D)金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分 30 解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及 び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は 水を生成する化合物を必須成分として含有する硬化性組 成物を用いて発光素子が被覆された発光ダイオードの製 造方法であって、前記硬化性組成物は、前記発光素子を 被覆する前にあらかじめ混合されて組成物中のSiH基 と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合とSiH基の一部 または全部が反応し金属原子及び/又は半金属原子に結 合した加水分解性基が加水分解縮合反応していることを 特徴とする発光ダイオードの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学材料に関するも のであり、更に詳しくは線膨張係数が小さく、さらに光 学的透明性が高い光学材料用組成物、光学材料、その製 造方法、およびそれを用いた液晶表示装置および発光ダ イオードに関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置用をはじめとする光学材料

的透明性の高い材料が使用される。また、液晶表示装置 用等の材料の場合には、製造プロセス上使用する材料に は高い耐熱性が必要である。とういった要求を満足する 材料として従来ガラス等が使用されてきた。

【0003】液晶表示装置用をはじめとする光学材料は 薄いフィルム状あるいは細いチューブやロッド状で多く 使用されるが、近年の市場要求に従い、より薄いフィル ム状、あるいはより細いチューブまたはロッド状での使 用が必要になってきている。しかし、従来使用されてき たガラスは強度的に脆い性質を有しているため、使用範 囲に限界が生じてきている。

【0004】強靭性のある材料としては高分子材料があ るが、例えば熱可塑性樹脂の場合は、一般に高い耐熱性 を発現させるために芳香族骨格を導入すると、複屈折率 が高くなり光弾性係数が大きくなるため、高い耐熱性と 光学的性能の両立が困難である。

【0005】熱硬化性樹脂の場合は、従来知られている 熱硬化性樹脂は一般に着色しており、光学材料用途には 向かない。さらに、一般に極性を有しており光学的性能 発現にも不利である。そこで、例えば発光ダイオードの 封止材用途では、特殊な熱硬化性樹脂として、酸無水物 系硬化剤を用いる透明エポキシ樹脂が広く用いられてき た。しかし、かかる透明エボキシ樹脂においても、樹脂 の吸水率が高いために耐湿耐久性が低い、あるいは、特 に低波長の光に対する光線透過性が低いために耐光耐久 性が低い、あるいは光劣化により着色するという欠点を 有していた。一方、耐光耐久性が高い被覆材として、シ リコーン樹脂が使用されているが、一般に軟質であり表 面タック性を有しているため、実装する際に発光面に異 物が付着したり実装用器具により発光面が損傷を受ける という問題があった。

【0006】また、高分子材料は一般に線膨張係数が大 きく加熱成形時の寸法安定性が低くなりやすいため、種 々のフィラーを添加する場合があるが、この場合、一般 的な粒子状フィラーを添加すると光学的な透明性が損な われるという問題があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、光劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さらに光学 的透明性が高く、実装する際に発光面に異物が付着した 40 り実装用器具により発光面が損傷を受けるという問題が 生じない、光学材料用組成物、光学材料、その製造方 法、およびそれを用いた液晶表示装置および発光ダイオ ードを提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた めに本発明者らは鋭意研究の結果、SiH基と反応性を 有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個 含有する有機化合物と、1分子中に少なくとも2個のS としては、複屈折率が低く、光弾性係数が小さく、光学 50 iH基を含有するケイ素化合物と、ヒドロシリル化触媒

と、金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解 性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物と、水 及び/又は水を生成する化合物を必須成分として光学材 料用組成物とすることにより、上記課題を解決できるこ とを見出し、本発明に至った。

【0009】すなわち、本発明は、(A) Si H基と反 応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくと も2個含有する有機化合物、(B)1分子中に少なくと も2個のSiH基を含有するケイ素化合物、(C)ヒド ロシリル化触媒、(D)金属原子及び/又は半金属原子 10 に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含 有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに (E) 水及び/又は水を生成する化合物を必須成分とし て含有することを特徴とする光学材料用組成物(請求項 1) であり、(A) 成分が、SiH基と反応性を有する ビニル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合 物であることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組 成物(請求項2)であり、(A)成分が、SiH基と反 応性を有するアリル基を1分子中に少なくとも1個含有 する有機化合物であることを特徴とする請求項1記載の 20 光学材料用組成物(請求項3)であり、(A)成分が、 1, 2-ポリブタジエン、ピニルシクロヘキセン、シク ロベンタジエン、ジシクロベンタジエン、ジビニルビフ ェニル、またはビスフェノールAジアリルエーテルであ ることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物 (請求項4)であり、(A)成分が、トリアリルイソシ アヌレート、またはトリビニルシクロヘキサンであると とを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物(請求 項5)であり、さらに(F)縮合触媒を必須成分として 含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一 30 項に記載の光学材料用組成物(請求項6)であり、

(F)縮合触媒がTi系縮合触媒であることを特徴とす る請求項6記載の光学材料用組成物(請求項7)であ り、(D)成分の金属原子が、Al、Zn、Ga、G e、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrからなる群より 選ばれる一種あるいは複数の原子であり、半金属原子が B及び/又はSiであることを特徴とする請求項1乃至 7のいずれか一項に記載の光学材料用組成物 (請求項 8)であり、(D)成分の加水分解性基が、アルコキシ 基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基からな 40 る群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを特 徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の光学材 料用組成物(請求項9)であり、光学材料が液晶用フィー ルムである請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学 材料用組成物(請求項10)であり、光学材料が液晶用 プラスチックセルである請求項1乃至9のいずれか一項 に記載の光学材料用組成物(請求項11)であり、光学 材料が発光ダイオードの封止材である請求項1乃至9の いずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項12)

. 6

材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のSiH基 と反応性を有する炭素-炭素二重結合とSiH基の一部 または全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子 に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応させること によって硬化させてなる光学材料 (請求項13) であ り、請求項1乃至12にいずれか一項に記載の光学材料 用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のSiH基と反 応性を有する炭素-炭素二重結合とSiH基の一部また は全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子に結 合した加水分解性基を加水分解縮合反応させることによ る、請求項13に記載の光学材料を製造する方法(請求 項14)であり、請求項13に記載の光学材料を用いた 液晶表示装置(請求項15)であり、請求項13に記載 の光学材料を用いた発光ダイオード(請求項16)であ る。

【0010】また、本発明の発光ダイオードは、(A) SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子 中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子 中に少なくとも2個のSiH基を含有するケイ素化合 物、(C)ヒドロシリル化触媒、(D)金属原子及び/ 又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少 なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮 合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を 必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子 が被覆された発光ダイオード(請求項17)であり、 (A) 成分は、SiH基と反応性を有するビニル基を1 分子中に少なくとも1個含有する有機化合物であること

を特徴とする請求項17記載の発光ダイオード(請求項 18)であり、(A)成分は、SiH基と反応性を有す るアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化 合物であることを特徴と請求項17記載の発光ダイオー ド(請求項19)であり、(A)成分は、1,2-ポリ プタジエン、ビニルシクロヘキセン、シクロペンタジエ ン、ジシクロペンタジエン、ジビニルピフェニル、また はピスフェノールAジアリルエーテルであることを特徴 とする請求項17記載の発光ダイオード(請求項20): であり、(A)成分は、トリアリルイソシアヌレート、 またはトリビニルシクロヘキサンであることを特徴とす る請求項17記載の発光ダイオード(請求項21)であ り、前記硬化性組成物が、さらに(F)縮合触媒を必須 成分として含有することを特徴とする請求項17乃至2 1のいずれか一項に記載の発光ダイオード(請求項2 2) であり、(F) 縮合触媒は、Ti系縮合触媒である ことを特徴とする請求項22に記載の発光ダイオード (請求項23)であり、(D)成分の金属原子は、A 1、Zn、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及び Zrからなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子で あり、半金属原子は、B及び/又はSiであることを特 徴とする請求項17乃至23のいずれか一項に記載の発 であり、請求項1乃至12のいずれか一項に記載の光学 50 光ダイオード(請求項24)であり、(D)成分の加水

分解基は、アルコキシ基、シロキシ基、アシロキシ基、 及びハロゲン基からなる群より選ばれる一種あるいは複 数の基であることを特徴とする請求項17乃至24のい ずれかに記載の発光ダイオード(請求項25)である。 【0011】また、本発明の発光ダイオードは、前記硬 化性組成物が、前記発光素子を被覆する前にあらかじめ 混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金属 原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が加 水分解縮合反応していることを特徴とする請求項17乃 10 至25のいずれか一項に記載の発光ダイオード (請求項 26)であり、前記発光素子は、珪素を含有する無機化 合物層を表面に有し、前記無機化合物層に接して、前記 硬化性組成物から得られる透光性封止材が設けられてい ることを特徴とする請求項17乃至26のいずれか一項 に記載の発光ダイオード(請求項27)であり、前記無 機化合物層は、前記発光素子から発光される光の少なく とも一部を吸収して他の波長を有する光を発光すること が可能な蛍光物質を有することを特徴とする請求項27 記載の発光ダイオード(請求項28)である。また、請 20 求項29に記載の発光ダイオードの製造方法は、(A) SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子 中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B)1分子 中に少なくとも2個のSiH基を含有するケイ素化合 物、(C)ヒドロシリル化触媒、(D)金属原子及び/ 又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少 なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮 合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を 必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子 が被覆された発光ダイオードの製造方法であって、前記 30 硬化性組成物は、前記発光素子を被覆する前にあらかじ め混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素 -炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金 属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が 加水分解縮合反応していることを特徴とする。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【0013】まず、本発明における(A)成分について説明する。(A)成分はSiH基と反応性を有する炭素 - 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 40機化合物であれば特に限定されない。有機化合物としてはポリシロキサンー有機ブロックコポリマーやポリシロキサンー有機グラフトコポリマーのようなシロキサン単位(Si-O-Si)を含むものではなく、構成元素としてC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものであることが好ましい。シロキサン単位を含むものの場合は、ガス透過性やはじきの問題がある。

【0014】SiH基と反応性を有する炭素 − 炭素二重 結合の結合位置は特に限定されず、分子内のどこに存在 してもよい。 8 【0015】(A)成分の有機化合物は、有機重合体系 の化合物と有機単量体系化合物に分類できる。

【0016】有機重合体系化合物としては例えば、ポリエーテル系、ポリエステル系、ポリアリレート系、ポリカーボネート系、飽和炭化水素系、不飽和炭化水素系、ポリアクリル酸エステル系、ポリアミド系、フェノールーホルムアルデヒド系(フェノール樹脂系)、ポリイミド系の化合物を用いるととができる。

【0017】また有機単量体系化合物としては例えば、フェノール系、ビスフェノール系、ベンゼン、ナフタレン等の芳香族炭化水素系;直鎖系、脂環系等の脂肪族炭化水素系;複素環系の化合物およびこれらの混合物等が挙げられる。

【0018】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合としては特に限定されないが、下記一般式(I)

[0019]

【化1】

$$R^{T}$$
 $CH_{2}=C$
 $CH_{2}=C$

【0020】(式中R¹ は水素原子あるいはメチル基を表す。)で示される基が反応性の点から好適である。また、原料の入手の容易さからは、

[0021]

【化2】

30 【0022】で示される基が特に好ましい。

【0023】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合としては、下記一般式(II)

[0.024]

【化3】

$$R_1$$
 (II)

60 【0025】(式中R'は水素原子あるいはメチル基を表す。)で示される脂環式の基が、硬化物の耐熱性が高いという点から好適である。また、原料の入手の容易さからは、

[0026]

【化4】

50

【0027】で示される脂環式の基が特に好ましい。 【0028】SiH基と反応性を有する炭素 - 炭素二重 結合は(A)成分の骨格部分に直接結合していてもよ く、2価以上の置換基を介して共有結合していても良 い。2価以上の置換基としては炭素数0~10の置換基* *であれば特に限定されないが、構成元素としてC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものが好ましい。これらの置換基の例としては、

[0029]

【化5】

-(CH₂)

(nは1~10の数を表す。),

(nは0~4の数を表す。)

[0030] [化6]

(nは0~4の数を表す。)

【0031】が挙げられる。また、これらの2価以上の 置換基の2つ以上が共有結合によりつながって1つの2 価以上の置換基を構成していてもよい。 【0032】以上のような骨格部分に共有結合する基の例としては、ビニル基、アリル基、メタリル基、アクリル基、メタクリル基、2-ヒドロキシー3-(アリルオキシ)プロピル基、2-アリルフェニル基、3-アリルフェニル基、4-アリルフェニル基、3-(アリルオキシ)フェニル基、3-(アリルオキシ)フェニル基、2-(アリルオキシ) エチル基、2,2-ビス(アリルオキシメチル)ブチル基、3-アリルオキシー2,2-ビス(アリルオキシメチル)ブロビル基、

[0033] [化7]

11

CH2=CH-CH2 (0-CH2-CH2)

(nは5≥n≥2を満足する数を表す。),

$$\begin{array}{c|c} H & H \\ C & CH \\ CH_2 & CH_2 \\ CH & CH_2 \\ CH_2 \\ CH & CH_2 \\ CH_2$$

(nは0~4の数を表す。)

【0034】が挙げられる。

【0035】(A)成分の具体的な例としては、ジアリルフタレート、トリアリルトリメリテート、ジエチレングリコールピスアリルカーボネート、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、1,1,2,2-テトラアリロキシエタン、ジアリリデンペンタエリスリット、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、1,2,4-トリビニルシクロヘキサン、ジビニルベンゼン類(純度 30

 $50\sim100\%$ のもの、好ましくは純度 $80\sim100\%$ のもの)、ジビニルビフェニル、1, 3 – ジイソプロペニルベンゼン、1, 4 – ジイソプロペニルベンゼン、およびそれらのオリゴマー、1, 2 – ポリブタジエン(1, 2 比率 $10\sim100\%$ のもの、好ましくは1, 2 比率 $50\sim100\%$ のもの)、ノボラックフェノールのアリルエーテル、アリル化ポリフェニレンオキサイド、 $\{0036\}$

$$(R1\pm -0-, -CH_2-, -\frac{CH_3}{CH_3}, -\frac{CF_3}{CF_3}, 0$$

(n = 1)

[0037]

【化9】

【0038】の他、従来公知のエポキシ樹脂のグリシジ ル基をアリル基に置き換えたもの等が挙げられる。

【0039】(A)成分としては、上記のように骨格部 分と炭素-炭素二重結合とに分けて表現しがたい、低分 子量化合物も用いることができる。これらの低分子量化 合物の具体例としては、ブタジエン、イソプレン、オク タジエン、デカジエン等の脂肪族鎖状ポリエン化合物 系、シクロペンタジエン、シクロヘキサジエン、シクロ 40 オクタジエン、ジシクロペンタジエン、トリシクロペン タジエン、ノルボルナジエン等の脂肪族環状ポリエン化 合物系、ビニルシクロペンテン、ビニルシクロヘキセン 等の置換脂肪族環状オレフィン化合物系等が挙げられ る。

【0040】上記した(A)成分としては、耐熱性をよ り向上し得るという観点から、SiH基と反応性を有す る炭素-炭素二重結合を(A)成分1gあたり0.00 1m01以上含有するものであればよいが、さらに、1 gあたり0.005mol以上含有するものが好まし

く、0.008mol以上含有するものが特に好まし 63.

【0041】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭 素−炭素二重結合の数は、平均して1分子当たり少なく とも2個あればよいが、力学強度をより向上したい場合 には2を越えることが好ましく、3個以上であることが より好ましい。(A)成分のSiH基と反応性を有する 炭素 - 炭素二重結合の数が1分子当たり1個以下の場合 は、(B)成分と反応してもグラフト構造となるのみで 架橋構造とならない。

【0042】(A)成分としては、他の成分との均一な 混合、および良好な作業性を得るためには100℃以下 の温度において流動性があるものが好ましく、線状でも 枝分かれ状でもよく、分子量は特に制約はないが、50 ~100,000の任意のものが好適に使用できる。分 子量が100,000以上では一般に原料が高粘度とな り作業性に劣るとともに、炭素 - 炭素二重結合とSiH 50 基との反応による架橋の効果が発現し難い。

【0043】また、(A)成分としては、着色特に黄変 の抑制の観点からフェノール性水酸基および/あるいは フェノール性水酸基の誘導体を有する化合物の含有量が 少ないものが好ましく、フェノール性水酸基および/あ るいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物を含 まないものがより好ましい。本発明におけるフェノール 性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン 環等に例示される芳香族炭化水素核に直接結合した水酸 基を示し、フェノール性水酸基の誘導体とは上述のフェ ノール性水酸基の水素原子をメチル基、エチル基等のア ルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、アセ トキシ基等のアシル基等により置換された基を示す。

【0044】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等 のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好で あるという観点からは、芳香環の(A)成分中の成分重 量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量 %以下のものがより好ましく、30重量%以下のものが さらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を 含まないものである。

【0045】得られる硬化物の着色性および光学特性か 20 ら、(A)成分としてはビニルシクロヘキセン、ジシク ロベンタジエン、トリアリルイソシアヌレート、2.2 - ピス(4 - ヒドロキシシクロヘキシル)プロバンのジ アリルエーテル、1,2,4-トリピニルシクロヘキサ ンが好ましく、トリアリルイツシアヌレート、2,2-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパンのジア リルエーテル、1,2,4-トリピニルシクロヘキサン が特に好ましい。

【0046】次に、(B) 成分であるSiH基を有する 化合物について説明する。

【0047】本発明に使用できるSiH基を有する化合 物については特に制限がなく、例えば国際公開WO96 /15194に記載される化合物で、1分子中に少なく とも2個のSiH基を有するもの等が使用できる。

【0048】これらのうち、入手性の面からは、1分子 中に少なくとも2個のSiH基を有する鎖状、及び/又 は、環状ポリオルガノシロキサンが好ましく、(A)成 分との相溶性が良いという観点から、さらに、下記一般 式(III)

[0049]

【化10】

$$\begin{pmatrix}
R^2 \\
S_{i} & O \\
H
\end{pmatrix}_{n}$$
(III)

【0050】(式中、R² は炭素数1~6の有機基を表 し、nは3~10の数を表す。)で表される、1分子中 に少なくとも2個のSiH基を有する環状ポリオルガノ れる化合物中の置換基R² は、C、H、Oから構成され るものであることが好ましく、炭化水素基であることが より好ましい。

【0051】また、前記(A)成分と良好な相溶性を有 するという観点からは、鎖状、及び/又は、環状ポリオ ルガノシロキサンと、炭素-炭素二重結合を有する有機 化合物から選ばれた1種以上の化合物(以降(G)成分 と称する)との反応物も好ましい。この場合、反応物の (A) 成分との相溶性をさらに高めるために、反応物か ら未反応のシロキサン類等を脱揮等により除去したもの を用いることもできる。

【0052】(G)成分はSiH基と反応性を有する炭 素-炭素二重結合を1分子中に少なくとも1個含有する 有機化合物であって、前記(A)成分と同じ説明のもの も使用できる。(G)成分の有機化合物は、(A)成分 の有機化合物と同じであってもよく、異なっていてもよ い。また単独もしくは2種以上のものを混合して用いる ことが可能である。(B)成分の(A)成分に対する相 溶性を高くしたい場合には、(G)成分は(A)成分と 同一のものが好ましい。

【0053】(G)成分の有機化合物と反応させる鎖 状、及び/又は、環状ポリオルガノシロキサンとして は、工業的入手性および反応させる場合の反応性が良好 であるという観点からは、1、3、5、7ーテトラメチ ルシクロテトラシロキサンが好ましい。

【0054】(B)成分としても(A)成分と同様に、 着色特に黄変の抑制の観点からフェノール性水酸基およ び/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合 物の含有量が少ないものが好ましく、フェノール性水酸 基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有す る化合物を含まないものがより好ましい。本発明におけ るフェノール性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、 アントラセン環等に例示される芳香族炭化水素核に直接 結合した水酸基を示し、フェノール性水酸基の誘導体と は上述のフェノール性水酸基の水素原子をメチル基、エ チル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケ ニル基、アセトキシ基等のアシル基等により置換された 基を示す。

【0055】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等 40 のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好で あるという観点からは、芳香環の(B)成分中の成分重 量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量 %以下のものがより好ましく、30重量%以下のものが さらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を 含まないものである。

【0056】光学特性が良好であるという観点からより 好ましい(B)成分としては、1,3,5,7-テトラ メチルシクロテトラシロキサンとビニルシクロヘキセン の反応物、1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラ シロキサンが好ましい。なお、一般式(III)で表さ 50 シロキサンとジシクロペンタジエンの反応物、1.3.

(11)

פנ

5、7-テトラメチルシクロテトラシロキサンとトリアリルイソシアヌレートの反応物、1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラシロキサンと2、2-ビス(4-ヒドロキシシクロへキシル)プロバンのジアリルエーテルの反応物、1、3、5、7-テトラメチルシクロへキサンの反応物が挙げられ、特に好ましい(B)成分としては、1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラシロキサンと2、2-ビス(4-ヒドロキシシクロへキシル)プロバンのジアリルエーテルの反応物、1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラシロキサンと2、2アリルエーテルの反応物、1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラシロキサンの反応物等が挙げられる。

【0057】上記したような(A)成分と(B)成分の混合比率は、必要な強度を失わない限りは特に限定されないが、(B)成分中のSiH基の数(Y)の(A)成分中の炭素-炭素二重結合の数(X)に対する比が、2.0 \geq Y/X \geq 0.9であることが好ましく、1.8 \geq Y/X \geq 1.0がより好ましい。2.0<Y/Xの場20合は、十分な硬化性が得られず、充分な強度が得られない場合があり、Y/X<0.9の場合は炭素-炭素二重結合が過剰となり着色の原因となり得る。

【0058】次に(C)成分であるヒドロシリル化触媒について説明する。

【0059】ヒドロシリル化触媒としては、ヒドロシリ ル化反応の触媒活性があれば特に限定されないが、例え ぱ、白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボンブラック 等の担体に固体白金を担持させたもの、塩化白金酸、塩 化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等との錯 体、白金-オレフィン錯体(例えば、Pt (CH2 = C H_2)₂ (PPh₃)₂, Pt (CH₂ = CH₂)₂ C l2)、白金-ビニルシロキサン錯体(例えば、Pt (ViMe₂ SiOSiMe₂ Vi)_n, Pt [(Me ViSiO)。]。)、白金-ホスフィン錯体 (例え ば、Pt (PPh。) 。、Pt (PBu。) 。)、白金 ーホスファイト錯体(例えば、Pt[P(OPh),] ▲、Pt [P(OBu)。]。) (式中、Meはメチル 基、Buはブチル基、Viはビニル基、Phはフェニル 基を表し、n、mは、整数を示す。)、ジカルボニルジ 40 クロロ白金、カールシュテト (Karstedt) 触 媒、また、アシュビー(Ashby)の米国特許第31 59601号および3159662号明細書中に記載さ れた白金ー炭化水素複合体、ならびにラモロー(Lam oreaux)の米国特許第3220972号明細書中 に記載された白金アルコラート触媒が挙げられる。さら に、モディック (Modic) の米国特許第35169 46号明細書中に記載された塩化白金-オレフィン複合 体も本発明において有用である。

【0060】また、白金化合物以外の触媒の例として

は、RhCl (PPh)。、RhCl。、RhAl2O。、RuCl。、IrCl。、FeCl。、AlCl。、PdCl2・2H2O、NiCl2、TiCl4、等が挙げられる。

【0061】これらの中では、触媒活性の点から塩化白金酸、白金-オレフィン錯体、白金-ピニルシロキサン 錯体等が好ましい。また、これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用してもよい。

【0062】触媒の添加量は特に限定されないが、十分な硬化性を有し、かつ組成物のコストを比較的低く抑えるために、SiH基1モルに対して、 $10^{-6}\sim10^{-1}$ モルの範囲が好ましく、より好ましくは、 $10^{-6}\sim10^{-2}$ モルの範囲である。

【0063】また、上記触媒には助触媒を併用することが可能であり、例としてトリフェニルホスフィン等のリン系化合物、ジメチルマレエート等の1、2-ジェステル系化合物、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-ブチン等のアセチレンアルコール系化合物、単体の硫黄等の硫黄系化合物、トリエチルアミン等のアミン系化合物等が挙げられる。助触媒の添加量は特に限定されないが、触媒1モルに対して、 $10^{-2}\sim10^2$ モルの範囲が好ましく、より好ましくは $10^{-1}\sim10$ モルの範囲である。

【0064】さらに本発明の組成物の保存安定性を改良

する目的、あるいは製造過程でのヒドロシリル化反応の 反応性を調整する目的で、硬化遅延剤を使用することが できる。硬化遅延剤としては、脂肪族不飽和結合を含有 する化合物、有機リン化合物、有機イオウ化合物、窒素 含有化合物、スズ系化合物、有機過酸化物等が挙げら 30 れ、これらを併用してもかまわない。脂肪族不飽和結合 を含有する化合物として、プロバルギルアルコール類、 エンーイン化合物類、マレイン酸エステル類等が例示さ れる。有機リン化合物としては、トリオルガノフォスフ ィン類、ジオルガノフォスフィン類、オルガノフォスフ ォン類、トリオルガノフォスファイト類等が例示され る。有機イオウ化合物としては、オルガノメルカプタン 類、ジオルガノスルフィド類、硫化水素、ベンゾチアゾ ール、ベンゾチアゾールジサルファイド等が例示され る。窒素含有化合物としては、アンモニア、1~3級ア ルキルアミン類、アリールアミン類、尿素、ヒドラジン 等が例示される。スズ系化合物としては、ハロゲン化第 ースズ2水和物、カルボン酸第一スズ等が例示される。 有機過酸化物としては、ジーt-ブチルペルオキシド、 ジクミルペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、過安

【0065】これらの硬化遅延剤のうち、遅延活性が良好で原料入手性がよいという観点からは、ベンゾチアゾール、チアゾール、ジメチルマレエート、3-ヒドロキシー3-メチルー1-ブチンが好ましい。

50 【0066】硬化遅延剤の添加量は、使用するヒドロシ

息香酸tーブチル等が例示される。

リル化触媒 1 m o l に対し、10⁻¹~10⁸ モルの節 囲が好ましく、より好ましくは1~50モルの範囲であ

【0067】次に(D)成分である金属原子及び/又は 半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なく とも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物 について説明する。

【0068】(D)成分の金属原子としては長周期表に おいてBとAtを結ぶ線より左に位置する任意の原子を 手しやすく工業的実用性が高いという点においては、A I. Zn. Ga. Ge. Sn. Mg. Ca. Ti. Zr が好ましく、Al、Tiがより好ましい。

【0069】(D)成分の半金属原子としては長周期表 においてBとAtを結ぶ線上あるいはそれに隣接する場 所に位置する任意の原子を用いることができる。これら のうち、原料が工業的に入手しやすく工業的実用性が高 いという点においては、B、Siが好ましく、Siがよ り好ましい。

【0070】これらの金属原子及び/又は半金属原子は 20 一種のものであってもよいし、複数のものを組み合わせ て用いてもよい。

【0071】(D)成分の金属原子及び/又は半金属原 子に結合した加水分解性基としては、加水分解縮合反応 性を有する基であれば各種のものを用いることができる が、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、 イソプロポキシ基、ブトキシ基、t-ブトキシ基、se c-ブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシロキシ基、ヘブ チロキシ基、オクチロキシ基、2-エチルヘキシロキシ シ基、メトキシメトキシ基、2-メトキシエトキシ基、

[0072] 【化11】

【0073】などのアルコキシ基、トリメチルシロキシ 基、トリフェニルシロキシ基、ジメチルフェニルシロキ シ基、メチルジフェニルシロキシ基、ジメチルt-ブチ 40 ウムアルコキシド類、ジメトキシ亜鉛、ジエトキシ亜 ルシロキシ基などのシロキシ基、ホルミロキシ基、アセー チロキシ基、エチルカルボキシ基、プロビルカルボキシ 基、フェニルカルボキシル基、メトキシカルボキシル 基、フェノキシカルボキシル基などのアシロキシ基、ク ロロ基、ブロモ基などのハロゲン基、ジメチルアミノ 基、ジフェニルアミノ基などのアミノ基などが挙げられ る。

【0074】反応性が良好であり、ヒドロシリル化反応 を阻害し難いという点からは、アルコキシ基、シロキシ

ち、アルコキシ基、シロキシ基がより好ましく、アシロ キシ基、ハロゲン基の場合は酸性の揮発分を有するため 硬化時の金型を腐食するなどの問題がある。脱離基を揮 発により除去し易いという点においてはアルコキシ基が さらに好ましく、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポ キシ基、ブトキシ基が特に好ましい。

【0075】上記したような(D)成分の例としては、 テトラメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジ メチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ 用いることができる。これらのうち、原料が工業的に入 10 ン、ジフェニルジメトキシシラン、テトラフェノキシシ ラン、メチルトリフェノキシシラン、ジメチルジフェノ キシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリエトキ シシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、テトラブ ロポキシシラン、テトラブトキシシランなどのアルコキ シシラン類、テトラアセトキシシランなどのアシロキシ シラン類、テトラ (トリメチルシロキシ) シランなどの シロキシシラン類、テトラクロロシラン、メチルトリク ロロシランなどのハロゲン化シラン類、アルミニウムト リメトキシド、アルミニウムトリエトキシド、アルミニ ウムトリイソプロポキシド、アルミニウムトリブトキシ ド、アルミニウムsec-ブトキシジイソプロポキシ ド、アルミニウムトリsec‐ブトキシド、アルミニウ ムエチルアセトアセテートジイソプロポキシド、アルミ ニウムトリスエチルアセトアセテート、アルミニウムア セチルアセトネートビスエチルアセトアセテート、アル ミニウムトリスアセチルアセテートなどのアルミニウム アルコキシド類、塩化アルミニウムなどのハロゲン化ア ルミニウム類、テトラメトキシチタン、テトラエトキシ 基、シクロヘキシロキシ基、ベンジロキシ基、フェノキ 30 チタン、テトライソプロポキシチタン、テトラブトキシ チタンなどのアルコキシチタン類、四塩化チタンなどの ハロゲン化チタン類、ボロントリメトキシド、ボロント リエトキシド、ボロントリイソプロポキシド、ボロント リブトキシドなどのボロンアルコキシド類、ジルコニウ ムテトライソプロポキシドなどのジルコニウムアルコキ シド類、マグネシウムメトキシド、マグネシウムエトキ シド、マグネシウムイソプロポキシドなどのマグネシウ ムアルコキシド類、カルシウムメトキシド、カルシウム エトキシド、カルシウムイソプロポキシドなどのカルシ 鉛、シイソプロポキシ亜鉛などのアルコキシ亜鉛類な ど、およびそれらの部分縮合物などを挙げることができ

> 【0076】反応性が良好で、線膨張係数の低減化効果 が高いという点においては、テトラメトキシシラン、テ トラエトキシシランが好ましく、反応性が良好で、得ら れる硬化物の靭性を損ない難いという観点からは、メチ ルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシランが好 ましい。

基、アシロキシ基、ハロゲン基が好ましい。これらのう 50 【0077】(D)成分としては上記したようなものの

22

うち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合 わせて用いてもよい。

【0078】 (D) 成分の添加量としては任意の量を添加できるが、(D) 成分が加水分解縮合反応して得られるものの量が、全組成物中の $5\sim70$ 重量%、好ましくは $10\sim50$ 重量%となるように添加することが好ましい。少ないと線膨張係数低減化効果が少ないし、多いと得られる硬化物が脆くなることがある。

【0079】(D)成分と合わせて金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を一分子中に1個有 10 する化合物を併用してもよい。これらの化合物としては、例えばトリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルフェニルエトキシシラン、メチルジフェニルメトキシシラン、トリフェニルエトキシシラン、トリフェニルエトキシシラン、トリフェニルエトキシシランなどのモノアルコキシシランを挙げることができる。

【0080】次に(E)成分について説明する。

【0081】(E)成分としては水の他に水を生成する化合物を用いることができる。水を生成する化合物とし 20 ては、例えば、縮合により水を生成する、トリメチルシラノール、トリフェニルシラノールなどシラノール基を有する化合物や、水を吸着したシリカ、結晶水を含む有機及び/又は無機の結晶などを挙げることができる。

【0082】(E)成分としては上記したようなもののうち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合わせて用いてもよい。

【0083】(E)成分の添加量としては任意の量を添加できるが、(E)成分から発生する水の量が、(D)成分のすべての加水分解性基を加水分解縮合するために 30必要な水の理論量に対して50~200モル%となる量が好ましく、80~120モル%となる量がより好ましい。少なくても多くても線膨張係数低減化効果が得られ難いことがある。

【0084】次に(F)成分について説明する。

ルアミン、ラウリルアミン、ジブチルアミン、モノエタ ノールアミン、トリエチレンテトラミン、オレイルアミ ン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミン、ジェチル アミノプロピルアミン、キシリレンジアミン、トリエチ レンジアミン、グアニジン、ジフェニルグアニジン、 2, 4, 6-トリス (ジメチルアミノメチル) フェノー ル、モルホリン、N-メチルモルホリン、2-エチルー 4-メチルイミダゾール、1、8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデセン-7 (DBU) などのアミン 化合物、あるいはこれらアミン化合物のカルボン酸など との塩、過剰のポリアミンと多塩基酸とから得られる低 分子量ポリアミド樹脂、過剰のポリアミンとエポキシ化 合物との反応生成物、ケーアミノブロビルトリメトキシ シラン、Ν-(β-アミノエチル) アミノプロピルメチ ルジメトキシシランなどのアミノ基を有するシランカッ プリング剤などが挙げられる。また、テトラブチルアン モニウムフルオライド、フッ化カリウム、フッ化ナトリ ウムなどのフッ素系化合物なども用いることができる。 その他、Sn、Sb、Zn、Fe、Co、Ti、Al、 Zr、Bなどの有機酸塩、アルコキシド、キレートとい った各種金属系縮合触媒など、従来公知の縮合触媒(シ ラノール縮合触媒) が挙げられる。 Sn系縮合触媒の具 体例としては、錫(II)メトキシド、錫(II)エト キシド、錫(11)2,4-ペンタンジオネート、錫 (【 【 】) オクトエート、酢酸錫(【 】)、ジブチル錫ジ ラウレート、ジブチル錫マレート、ジブチル錫ジアセテ ート、ナフテン酸錫、ジブチル錫オキサイドとフタル酸 エステルとの反応物、ジブチル錫ジアセチルアセトナー トなどが挙げられ、Sb系縮合触媒の具体例としては、 鉛(11) ヘキサブルオロペンタンジオネート、鉛(1 1) 2, 4-ペンタンジオネート、鉛(11) 2, 2, 6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオネート、 オクチル酸鉛などが挙げられ、乙n系縮合触媒の具体例 としては、ジメトキシ亜鉛、ジエトキシ亜鉛、亜鉛メト キシエトキシド、亜鉛2、4-ペンタンジオネート、酢 酸亜鉛、亜鉛2-エチルヘキサノエート、ギ酸亜鉛、メ タクリル酸亜鉛、亜鉛ネオデカノエート、ウンデシレン 酸亜鉛、オクチル酸亜鉛などが挙げられ、Fe系縮合触 媒の具体例としては、鉄(III)ベンゾイルアセトネ ート、鉄(I I I) エトキサイド、鉄(I I I) 2、4 -ペンタンジオネート、鉄(111) トリフルオロペン タンジオネート、オクチル酸鉄などが挙げられ、Co系 縮合触媒の具体例としては、コバルト(II)2,4-ペンタンジオネート、コバルト(III)2,4-ペン・ タンジオネートなどが挙げられ、T i 系縮合触媒の具体 例としては、ジイソプロボキシビス(アセト酢酸エチ ル) チタン、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチ ル) チタン、ジイソプロポキシビス (アセチルアセト ン)チタン、ジブトキシピス(アセト酢酸エチル)チター

アルミニウムトリイソプロポキシド、アルミニウムトリ 第2プトキシド、アルミニウムジイソプロポキシ第2ブ トキシド、アルミニウムジイソプロポキシドアセチルア セトナート、アルミニウムジ第2プトキシドアセチルア セトナート、アルミニウムジイソプロポキシドエチルア セトアセテート、アルミニウムジ第2 ブトキシドエチル アセトアセテートなどが挙げられ、乙ェ系縮合触媒の具 体例としては、ジルコニウムテトラブトキシド、ジルコ ニウムテトライソプロポキシド、ジルコニウムテトラメ トキシド、ジルコニウムトリプトキシドモノアセチルア セトナート、ジルコニウムジプトキシドビスアセチルア セトナート、ジルコニウムモノブトキシドトリスアセチ ルアセトナート、シルコニウムトリプトキシドモノエチ ルアセトアセテート、ジルコニウムジブトキシドビスエ チルアセトアセテート、ジルコニウムモノブトキシドト リスエチルアセトアセテート、ジルコニウムテトラアセ チルアセトナート、ジルコニウムテトラエチルアセトア セテートなどが挙げられ、B系縮合触媒の具体例として は、ホウ素メトキシド、ホウ素エトキシド、ホウ素n-ブトキシドなどが挙げられる。

【0086】これらのうち、ヒドロシリル化反応を阻害 し難いという点からは、中性の有機金属化合物が好まし く、さらに好ましくはTi系縮合触媒およびAl系縮合 触媒であり、特に好ましい触媒はTi系縮合触媒であ

【0087】(F)成分としては上記したようなものの うち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合 わせて用いてもよい。

【0088】(F)成分の添加量としては任意の量を添 加できるが、(D)成分100重量部に対して0.01 ~20重量部が好ましく、0.3~10重量部がより好 ましい。少ないと得られる硬化物に線膨張係数低減化効 果が得られ難い場合があり、多いと着色する場合があ

【0089】本発明の組成物としては上記したように各 種組み合わせのものが使用できるが、耐熱性が良好であ るという観点から、組成物を硬化させて得られる硬化物 のTgが50℃以上となるものが好ましく、100℃以 上となるものがさらに好ましく、150℃以上となるも のが特に好ましい。

【0090】本発明の組成物をそのままフィルムなどに 成形することも可能であるが、該組成物を有機溶剤に溶 解してワニスとすることも可能である。使用できる溶剤 は特に限定されるものではなく、具体的に例示すれば、 ベンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘプタンなどの炭化水 **素系溶媒、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、** ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、アセトン、メ チルエチルケトンなどのケトン系溶媒、クロロホルム、 塩化メチレン、1,2-ジクロロエタンなどのハロゲン 系溶媒を好適に用いることができる。溶媒は2種類以上 50 ム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体等の蛍光体や、

の混合溶媒として用いることもできる。溶媒としては、 トルエン、テトラヒドロフラン、クロロホルムが好まし い。使用する溶媒量は、用いる(A)成分1gに対し、 0~10mLの範囲で用いるのが好ましく、0.5~5 mLの範囲で用いるのがさらに好ましく、1~3 mLの 範囲で用いるのが特に好ましい。使用量が少ないと、低 粘度化などの溶媒を用いることの効果が得られにくく、 また、使用量が多いと、材料に溶剤が残留して熱クラッ クなどの問題となり易く、またコスト的にも不利になり 工業的利用価値が低下する。

【0091】本発明の組成物には、その他、老化防止 剤、ラジカル禁止剤、紫外線吸収剤、接着性改良剤、難 燃剤、界面活性剤、保存安定改良剤、オゾン劣化防止 剤、光安定剤、増粘剤、可塑剤、カップリング剤、酸化 防止剤、熱安定剤、導電性付与剤、帯電防止剤、放射線 遮断剤、核剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、金 属不活性化剤、物性調整剤などを本発明の目的および効 果を損なわない範囲において添加することができる。な お、カップリング剤としては例えばシランカップリング 剤が挙げられる。シランカップリング剤としては、分子 中に有機基と反応性のある官能基と加水分解性のケイ素 基を各々少なくとも1個有する化合物であれば特に限定 されない。有機基と反応性のある基としては、取扱い性 の点からエポキシ基、メタクリル基、アクリル基、イソ シアネート基、イソシアヌレート基、ビニル基、カルバ メート基から選ばれる少なくとも1個の官能基が好まし く、硬化性及び接着性の点から、エポキシ基、メタクリ ル基、アクリル基が特に好ましい。加水分解性のケイ素 基としては取扱い性の点からアルコキシシリル基が好ま しく、反応性の点からメトキシシリル基、エトキシシリ ル基が特に好ましい。好ましいシランカップリング剤と しては、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、2 - (3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメト キシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン等のエポキシ官能基を有する アルコキシシラン類;3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリエト キシシラン、3-アクリロキシプロピルトリメトキシシ 40 ラン、3-アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、 メタクリロキシメチルトリメトキシシラン、メタクリロ キシメチルトリエトキシシラン、アクリロキシメチルト リメトキシシラン、アクリロキシメチルトリエトキシシ ラン等のメタクリル基あるいはアクリル基を有するアル コキシシラン類が例示できる。

【0092】さらに、本発明の組成物には種々の発光ダ イオード特性改善のための添加剤を添加してもよい。添 加剤としては例えば、発光素子からの光を吸収してより 長波長の蛍光を出す、セリウムで付活されたイットリウ

特定の波長を吸収するブルーイング剤等の着色剤、光を拡散させるための酸化チタン、酸化アルミニウム、シリカ、石英ガラス等の酸化ケイ素、タルク、炭酸カルシウム、メラミン樹脂、CTUグアナミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂等のような各種無機あるいは有機拡散材、ガラス、アルミノシリケート等の金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ボロン等の金属窒化物等の熱伝導性フィラー等を挙げることができる。

【0093】発光ダイオード特性改善のための添加剤は 均一に含有させても良いし、含有量に傾斜を付けて含有 させてもよい。この様なフィラー含有樹脂部は発光面前 面のモールド部材用の樹脂を型に流した後、引き続い て、フィラーを含有させた樹脂を流し発光面後方のモー ルド部材として形成させることができる。また、モール ド部材形成後リード端子を表裏両面からテープを張り付 けることによって覆い、この状態でリードフレーム全体 をフィラー含有樹脂を溜めたタンク内に発光ダイオード のモールド部材の下半分を浸漬した後、引き上げて乾燥 させフィラー含有樹脂部を形成させても良い。

【0094】本発明で言う光学材料とは、可視光、赤外 20線、紫外線、X線、レーザーなどの光をその材料中を通過させる用途に用いる材料一般を示す。

【0095】より具体的には、液晶ディスプレイ分野に おける基板材料、導光板、プリズムシート、偏向板、位 相差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィ ルムなどの液晶用フィルムなどの液晶表示装置周辺材料 である。また、次世代フラットパネルディスプレイとし て期待されるカラーPDP (プラズマディスプレイ) の 封止材、反射防止フィルム、光学補正フィルム、ハウジ ング材、前面ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材 30 料、接着剤;また発光ダイオード表示装置に使用される 発光素子のモールド材、発光ダイオードの封止材、前面 ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤; またプラズマアドレス液晶(PALC)ディスプレイに おける基板材料、導光板、ブリズムシート、偏向板、位 相差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィ ルム:また有機EL (エレクトロルミネッセンス) ディ スプレイにおける前面ガラスの保護フィルム、前面ガラ ス代替材料、接着剤:またフィールドエミッションディ スプレイ(FED)における各種フィルム基板、前面ガ ラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤であ る。

【0096】光記録分野では、VD(ビデオディスク)、CD/CD-ROM、CD-R/RW、DVD-R/DVD-RAM、MO/MD、PD(相変化ディスク)、光カード用のディスク基板材料、ピックアップレンズ、保護フィルム、封止材、接着剤などである。

【0097】光学機器分野では、スチールカメラのレン とを混合する方法が好ましい。(A)成分、(B)成 ズ用材料、ファインダブリズム、ターゲットプリズム、 分、(D)成分、(E)成分の混合物に(C)成分を混 ファインダーカバー、受光センサー部である。また、ビ 50 合する方法だと反応の制御が困難である。(B)成分に

デオカメラの撮影レンズ、ファインダーである。またプロジェクションテレビの投射レンズ、保護フィルム、封止材、接着剤などである。光センシング機器のレンズ用材料、封止材、接着剤、フィルムなどである。

【0098】光部品分野では、光通信システムでの光スイッチ周辺のファイバー材料、レンズ、導波路、素子の封止材、接着剤などである。光コネクタ周辺の光ファイバー材料、フェルール、封止材、接着剤などである。光受動部品、光回路部品ではレンズ、導波路、発光素子の封止材、接着剤などである。光電子集積回路(OEIC)周辺の基板材料、ファイバー材料、素子の封止材、接着剤などである。

【0099】光ファイバー分野では、装飾ディスプレイ 用照明・ライトガイドなど、工業用途のセンサー類、表示・標識類など、また通信インフラ用および家庭内のデジタル機器接続用の光ファイバーである。

【0100】半導体集積回路周辺材料では、LSI、超 LSI材料用のマイクロリソグラフィー用のレジスト材 料である。

【0101】自動車・輸送機分野では、自動車用のランプリフレクタ、ベアリングリテーナー、ギア部分、耐蝕コート、スイッチ部分、ヘッドランプ、エンジン内部品、電装部品、各種内外装品、駆動エンジン、ブレーキオイルタンク、自動車用防錆鋼板、インテリアパネル、内装材、保護・結束用ワイヤーネス、燃料ホース、自動車ランプ、ガラス代替品である。また、鉄道車輌用の複層ガラスである。また、航空機の構造材の靱性付与剤、エンジン周辺部材、保護・結束用ワイヤーネス、耐蝕コートである。

30 【0102】建築分野では、内装・加工用材料、電気カバー、シート、ガラス中間膜、ガラス代替品、太陽電池 周辺材料である。農業用では、ハウス被覆用フィルムである。

【0103】次世代の光・電子機能有機材料としては、 有機EL素子周辺材料、有機フォトリフラクティブ素 子、光-光変換デバイスである光増幅素子、光演算素 子、有機太陽電池周辺の基板材料、ファイバー材料、素 子の封止材、接着剤などである。

【0104】本発明の光学材料用組成物は、あらかじめ 40 混合し、組成物中のSiH基と反応性を有する炭素-炭 素二重結合とSiH基の一部または全部を反応させ、金 属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を 加水分解縮合反応させることによって硬化させて光学材 料とすることができる。

【0105】混合の方法としては、各種方法をとることができるが、(A)成分に(C)成分、(E)成分を混合したものと、(B)成分に(D)成分を混合したものとを混合する方法が好ましい。(A)成分、(B)成分、(D)成分、(E)成分の混合物に(C)成分を混合する方法だと反応の制御が困難である。(B)成分に

(C)成分、(D)成分を混合したものに(A)成分に(E)成分を混合したものを混合する方法をとる場合は、(C)成分の存在下(B)成分が環境中の水分と反応性を有するため、貯蔵中などに変質することもある。(B)成分と(E)成分を混合した状態で保存すると、貯蔵中などに変質することもあるため、これらは別のコンポーネントに含有させるほうが好ましい。(F)成分を用いる場合には、(F)成分と(D)成分あるいは、(F)成分と(E)成分が反応性が高い場合があるので、これらの成分は分けて混合することが好ましい。具10体的には(A)成分に(C)成分、(F)成分を混合したものと、(B)成分に(C)成分、(C)成分、(C)成分、(C)成分、(C)成分、(D)成分、(E)成分を混合したものを混合する方法が好まし

【0106】組成物を反応させて硬化させる場合において、(A)、(B)、(C)各成分、あるいは(D)、(E)、(必要に応じて(F))各成分のそれぞれの必要量を一度に混合して反応させてもよいが、一部を混合 20して反応させた後残量を混合してさらに反応させる方法や、混合した後反応条件の制御や置換基の反応性の差の利用により組成物中の官能基の一部のみを反応(Bステージ化)させてから成形などの処理を行いさらに硬化させる方法をとることもできる。これらの方法によれば成形時の粘度調整が容易となる。

【0107】硬化させる方法としては、単に混合するだけで反応させることもできるし、加熱して反応させることもできる。反応が速く、一般に耐熱性の高い材料が得られやすいという観点から加熱して反応させる方法が好 30ましい。

【0108】この場合、(A)、(B)、(C)成分のヒドロシリル化反応と、(D)、(E)、必要に応じて(F)成分の加水分解縮合反応は、どちらかを優先的に反応させることもできるが、得られる硬化物がより透明になりやすいという点においては同時並行的に進行させる方が好ましい。同時並行的に進行させるためには、必要成分を徐々に添加する方法によることもできるが、

(C)成分の含有量や、(F)成分の含有量や、反応温度をそれぞれ調整することによっても可能であり、後者の方が簡便である。

【0109】反応温度としては種々設定できるが、例えば30~300℃の温度が適用でき、100~250℃がより好ましく、150~200℃がさらに好ましい。反応温度が低いと十分に反応させるための反応時間が長くなり、反応温度が高いと成形加工が困難となりやすい。

【0110】反応は一定の温度で行ってもよいが、必要 法によって、必要に応じてGaN、AlN等のバッファ に応じて多段階あるいは連続的に温度を変化させてもよ ・ 一層を設けた基板上に半導体材料を積層して作成したもい。一定の温度で行うより多段階的あるいは連続的に温 50 のが挙げられる。この場合の基板としては、各種材料を

度を上昇させながら反応させた方が、歪のない均一な硬化物が得られやすいという点において好ましい。

【0111】反応時間も種々設定できるが、高温短時間で反応させるより、比較的低温長時間で反応させた方が、歪のない均一な硬化物が得られやすいという点において好ましい。

【0112】反応時の圧力も必要に応じ種々設定でき、 常圧、高圧、あるいは減圧状態で反応させることもでき る。加水分解縮合により発生する揮発分を除きやすいと いう点においては、減圧状態で反応させることが好まし い

【0113】硬化させて得られる光学材料の形状も用途 に応じて種々とりうるので特に限定されないが、例えば フィルム状、シート状、チューブ状、ロッド状、塗膜 状、バルク状などの形状とすることができる。

【0114】成形する方法も従来の熱硬化性樹脂の成形方法をはじめとして種々の方法をとることができる。例えば、キャスト法、プレス法、注型法、トランスファー成形法、コーティング法、RIM法などの成形方法を適用することができる。成形型は研磨ガラス、硬質ステンレス研磨板、ポリカーボネート板、ポリエチレンテレフタレート板、ポリメチルメタクリレート板等を適用することができる。また、成形型との離型性を向上させるためポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリイミドフィルム等を適用することができる。

【0115】成形時に必要に応じ各種処理を施すとともできる。例えば、成形時に発生するボイドの抑制のために組成物あるいは一部反応させた組成物を遠心、減圧などにより脱泡する処理、プレス時に一旦圧力を開放する処理などを適用するとともできる。

【0116】本発明の光学材料を用いて液晶表示装置を 製造することができる。

【0117】この場合、本発明の光学材料を液晶用ブラスチックセル、偏光板、位相差板、偏光子保護フィルムなどの液晶用フィルムとして使用し、通常の方法によって液晶表示装置を製造すればよい。

【0118】本発明の光学材料を用いて発光ダイオードを製造することができる。この場合、発光ダイオードは上記したような組成物によって発光素子を被覆することによって製造することができる。

【0119】との場合発光素子とは、特に限定なく従来公知の発光ダイオードに用いられる発光素子を用いることができる。とのような発光素子としては、例えば、MOCVD法、HDVPE法、液相成長法といった各種方法によって、必要に応じてGaN、A1N等のバッファー層を設けた基板上に半導体材料を積層して作成したものが挙げられる。この場合の基板としては、各種材料を

32

用いることができるが、例えばサファイア、スピネル、SiC、Si、ZnO、GaN単結晶等が挙げられる。これらのうち、結晶性の良好なGaNを容易に形成でき、工業的利用価値が高いという観点からは、サファイアを用いることが好ましい。

【0120】積層される半導体材料としては、GaAs、GaP、GaAlAs、GaAsP、AlGaInP、GaN、InN、AlN、InGaN、InGaAlN、SiC等が挙げられる。これらのうち、高輝度が得られるという観点からは、窒化物系化合物半導体(I 10n、Ga、Al、N)が好ましい。このような材料には付活剤等を含んでいてもよい。

【0121】発光素子の構造としては、MIS接合、pn接合、PIN接合を有するホモ接合、ヘテロ接合やダブルヘテロ構造等が挙げられる。また、単一あるいは多重量子井戸構造とすることもできる。

【0122】発光素子はバッシベーション層を設けていてもよいし、設けなくてもよい。

【 0 1 2 3 】 発光素子には従来知られている方法によって電極を形成することができる。

【0124】発光素子上の電極は種々の方法でリード端子等と電気接続できる。電気接続部材としては、発光素子の電極とのオーミック性機械的接続性等が良いものが好ましいく、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウムやそれらの合金等を用いたボンディングワイヤーが挙げられる。また、銀、カーボン等の導電性フィラーを樹脂で充填した導電性接着剤等を用いることもできる。これらのうち、作業性が良好であるという観点からは、アルミニウム線或いは金線を用いることが好ましい。

【0125】上記のようにして発光素子が得られるが、本発明の発光ダイオードにおいては発光素子の光度としては垂直方向の光度が1cd以上であれば任意のものを用いることができるが、垂直方向の光度が2cd以上の発光素子を用いた場合により本発明の効果が顕著であり、3cd以上の発光素子を用いた場合にさらに本発明の効果が顕著である。

【0126】発光素子の発光出力としては特に限定なく任意のものを用いることができるが、20mAにおいて1mW以上の発光素子を用いた場合に本発明の効果が顕著であり、20mAにおいて4mW以上の発光素子を用いた場合により本発明の効果が顕著であり、20mAにおいて5mW以上の発光素子を用いた場合にさらに本発明の効果が顕著である。

【0127】発光素子の発光波長は紫外域から赤外域まで種々のものを用いることができるが、主発光ピーク波長が550nm以下のものを用いた場合に特に本発明の効果が顕著である。

【0128】用いる発光素子は一種類で単色発光させても良いし、複数用いて単色或いは多色発光させても良い。

【0129】本発明の発光ダイオードに用いられるリー ド端子としては、ボンディングワイヤー等の電気接続部 材との密着性、電気伝導性等が良好なものが好ましく、 リード端子の電気抵抗としては、300μΩ-сm以下 が好ましく、より好ましくは3μΩ-сm以下である。 これらのリード端子材料としては、例えば、鉄、銅、鉄 入り銅、錫入り銅や、これらに銀、ニッケル等をメッキ したもの等が挙げられる。これらのリード端子は良好な 光の広がりを得るために適宜光沢度を調整してもよい。 【0130】本発明の発光ダイオードは上記したような 組成物によって発光素子を被覆することによって製造す ることができるが、この場合被覆とは、上記発光素子を 直接封止するものに限らず、間接的に被覆する場合も含 む。具体的には、発光素子を本発明の組成物で直接従来 用いられる種々の方法で封止してもよいし、従来用いら れるエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ユ リア樹脂、イミド樹脂等の封止樹脂やガラスで発光素子 を封止した後に、その上あるいは周囲を本発明の組成物 で被覆してもよい。また、発光素子を本発明の組成物で 封止した後、従来用いられるエポキシ樹脂、シリコーン 樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂、イミド樹脂等でモー ルディングしてもよい。以上のような方法によって屈折 率や比重の差によりレンズ効果等の種々の効果をもたせ ることも可能である。

【0131】封止の方法としても各種方法を適用すると とができる。例えば、底部に発光素子を配置させたカッ プ、キャビティ、パッケージ凹部等に液状の組成物をデ ィスペンサーその他の方法にて注入して加熱等により硬 化させてもよいし、固体状あるいは高粘度液状の組成物 を加熱する等して流動させ同様にバッケージ凹部等に注 入してさらに加熱する等して硬化させてもよい。との場 合のパッケージは種々の材料を用いて作成することがで き、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンス ルフィド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコー ン樹脂、ABS樹脂等を挙げることができる。また、モ ールド型枠中に組成物をあらかじめ注入し、そこに発光 素子が固定されたリードフレーム等を浸漬した後硬化さ せる方法も適用することができるし、発光索子を挿入し た型枠中にディスペンサーによる注入、トランスファー 成形、射出成形等により組成物による封止層を成形、硬 化させてもよい。さらに、単に液状または流動状態とし た組成物を発光素子上に滴下あるいはコーティングして 硬化させてもよい。あるいは、発光素子上に孔版印刷。 スクリーン印刷、あるいはマスクを介して塗布すること 等により組成物を成形させて硬化させることもできる。 その他、あらかじめ板状、あるいはレンズ形状等に部分 硬化あるいは硬化させた組成物を発光素子上に固定する 方法によってもよい。さらには、発光素子をリード端子 やパッケージに固定するダイボンド剤として用いること 50 もできるし、発光素子上のバッシベーション膜として用

(18)

いることもできる。また、パッケージ基板として用いる **ともできる。**

【0132】被覆部分の形状も特に限定されず種々の形 状をとることができる。例えば、レンズ形状、板状、薄 膜状、特開平6-244458記載の形状等が挙げられ る。これらの形状は組成物を成形硬化させることによっ て形成してもよいし、組成物を硬化した後に後加工によ り形成してもよい。

【0133】本発明の発光ダイオードは、種々のタイプ とすることができ、例えば、ランプタイプ、SMDタイ 10 ブ、チップタイプ等いずれのタイプでもよい。SMDタ イブ、チップタイプのパッケージ基板としては、種々の ものが用いられ、例えば、エポキシ樹脂、BTレジン、 セラミック等が挙げられる。

【0134】その他、本発明の発光ダイオードには従来 公知の種々の方式が適用できる。例えば、発光素子背面 に光を反射あるいは集光する層を設ける方式、封止樹脂 の黄変に対応して補色着色部を底部に形成させる方式、 主発光ビークより短波長の光を吸収する薄膜を発光素子 上に設ける方式、発光素子を軟質あるいは液状の封止材 20 で封止した後周囲を硬質材料でモールディングする方 式、発光素子からの光を吸収してより長波長の蛍光を出 す蛍光体を含む材料で発光素子を封止した後周囲をモー ルディングする方式、蛍光体を含む材料をあらかじめ成 形してから発光素子とともにモールドする方式、特開平 6-244458に記載のとおりモールディング材を特 殊形状として発光効率を高める方式、輝度むらを低減さ せるためにバッケージを2段状の凹部とする方式、発光 ダイオードを貫通孔に挿入して固定する方式、発光素子 表面に主発光波長より短い波長の光を吸収する薄膜を形 30 成する方式、発光素子をはんだパンプ等を用いたフリッ ブチップ接続等によってリード部材等と接続して基板方 向から光を取出す方式、等を挙げることができる。

【0135】本発明の発光ダイオードは従来公知の各種 の用途に用いることができる。具体的には、例えばバッ クライト、照明、センサー光源、車両用計器光源、信号 灯、表示灯、表示装置、面状発光体の光源、ディスプレ イ、装飾、各種ライト等を挙げることができる。

[0136]

【実施例】以下に、本発明の実施例および比較例を示す が、本発明は以下によって限定されるものではない。

(合成例1)1Lの3つ口フラスコに、撹拌装置、冷却 管をセットした。このフラスコに、ピスフェノールA1 14g、炭酸カリウム145g、アリルブロマイド14 0g、アセトン250mLを入れ、60℃で12時間撹 拌した。上澄み液をとり、分液ロートで水酸化ナトリウ ム水溶液により洗浄し、その後水洗した。油層を硫酸ナ トリウムで乾燥させた後、エバポレーターで溶媒を留去 したところ、淡黄色の液体126gが得られた。 1 H- テル化したピスフェノールAジアリルエーテルであると とがわかった。収率は82%であり純度は95%以上で あった。

【0137】(合成例2)1Lの4つ口フラスコに、攪 拌装置、冷却管、滴下漏斗をセットした。このフラスコ にトルエン150g、白金ピニルシロキサン錯体のキシ レン溶液(白金として3wt%含有) 15.6 µL、 1, 3, 5, 7-テトラメチルシクロテトラシロキサン 500gを加えてオイルバス中で70℃に加温、攪拌し た。合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエー テル64gをトルエン40gで希釈して滴下漏斗から滴 下した。同温で60分撹拌後放冷し、ベンゾチアゾール 4. 74mgを添加した。未反応の1, 3, 5, 7-テ トラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減 圧留去し、やや粘ちょうな液体を得た。 H-NMRに よりこのものは1,3,5,7-テトラメチルシクロテ トラシロキサンのSiH基の一部がピスフェノールAジ アリルエーテルと反応したもの(部分反応物Aと称す) であることがわかった。

【0138】(合成例3)200mLの二口フラスコ に、磁気撹拌子、冷却管をセットした。このフラスコに トルエン50g、白金ピニルシロキサン錯体のキシレン 溶液(白金として3wt%含有)11.3μL、トリア 1/(1 + 1)ラメチルシクロテトラシロキサン37.04gを加え て、90℃のオイルバス中で30分加温、攪拌した。さ らに130°Cのオイルバス中で2時間加熱還流させた。 1-エチニル-1-シクロヘキサノール176mgを加 えた。未反応の1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテ トラシロキサンおよびトルエンを減圧留去した。 1 H‐ NMRによりこのものは1, 3, 5, 7-テトラメチル シクロテトラシロキサンのSiH基の一部がトリアリル イソシアヌレートと反応したもの(部分反応物Bと称 す) であることがわかった。

【0139】(実施例1)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16、1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、テトラメトキシシラ ン3. 1gと、水1. 0gと、ジイソプロポキシピス (アセト酢酸メチル) チタン0.5gと、THF3m1 とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ピニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色の ほぼ透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は 硬質で表面タックを有しないものであった。

【0140】(実施例2)合成例1で製造したピスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 NMRにより、ピスフェノールAのOH基がアリルエー 50 造した部分反応物A15.4gと、テトラメトキシシラ

36

ン15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン2. 0gと、THF3m1 とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ピニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色の フィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面 タックを有しないものであった。

【0141】(実施例3)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、テトラエトキシシラ ン3.1gと、水1.0gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン0.5gと、THF3m1 とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ 20 /24時間加熱を行い、やや黄色であるが透明なフィル ム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タック を有しないものであった。

【0142】(実施例4)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、テトラエトキシシラ ン15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン2. 0gと、THF3m1 とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ピニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、5.0°C/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、やや黄色であるが透明なフィル ム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タック を有しないものであった。

【0143】(実施例5)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、ボロントリメトキシ ド15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン2. 0gと、THF2m1 とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、やや褐色であるが透明なフィル ム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タック を有しないものであった。

ノールAシアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、ボロントリエトキシ ド15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン2. Ogと、THF2ml とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、やや褐色であるが透明なフィル ム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タック を有しないものであった。

【0145】(実施例7)合成例1で製造したビスフェ ノールAシアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、テトラメトキシシラ ンの部分縮合物(コルコート社製メチルシリケート5 1) 15. 8gと、水4. 4gと、ジイソプロポキシビ ス(アセト酢酸メチル)チタン3.5gと、THF2m 1とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部 分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシ ロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフ ィルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時 間、80℃/7時間、100℃/17時間、さらに15 0℃/24時間加熱を行い、やや黄色であるが透明なフ ィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タ ックを有しないものであった。

【0146】(実施例8)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A.15.4gと、メチルトリメトキシ 30 シランの部分縮合物(オーエンスイリノイ社製GR65 0) 3. 2gと、水1. 2gと、ジイソプロポキシピス (アセト酢酸メチル) チタン1. 8gと、THF2ml とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロ キサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィ ルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、 80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃ /24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色の フィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面 タックを有しないものであった。

【0147】(比較例1)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、粒子状シリカ(龍森 社製ヒューズレックスE-1) 15. 7g、THF2m 1とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部 分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシ ロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフ ィルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時 間、80℃/7時間、100℃/17時間、さらに15 【0144】(実施例6)合成例1で製造したビスフェ 50 0℃/24時間加熱を行い、白色不透明のフィルム状硬

化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有し ないものであった。

【0148】(比較例2)合成例1で製造したビスフェ ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製 造した部分反応物A15.4gと、THF2m1とをカ ップ中で混合した。合成例2で示したように部分反応物 Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン 錯体を含有している。このものをポリイミドフィルムを ひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、80℃ /7時間、100℃/17時間、さらに150℃/24 時間加熱を行い、透明なフィルム状硬化物を得た。得ら れた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであっ tc.

【0149】(測定例1)実施例3、5、8および比較 例2で作成した硬化物の線膨張係数を測定した。線膨張 係数は熱機械分析装置を用いて実施した。測定条件とし ては、フィルム状サンプルを3×15mmの短冊状に切 り出し、チャック間10mm、荷重3gの引張りモード にて、窒素気流下において昇温速度10℃/分として測 定し、40°Cから60°Cにおける平均線膨張係数を測定 20 造)、発光層上にMgがドープされたp型クラッド層と 値とした。結果は表1に示した。

[0150]

【表1】

	線膨張係数
	(ppm)
実施例3	72
実施例5	82
実施例8	70
比較例2	100

【0151】表1で示すとおり本発明の実施例では線膨 張係数が低減している。

【0152】(実施例9)トリアリルイソシアヌレート 2.5gと、合成例3で合成した部分反応物B3.0g と、テトラメトキシシラン3...1gと、水1.0gと、 ジイソプロポキシピス (アセト酢酸メチル) チタン0. 3gと、THF3mlとをカップ中で混合し、組成物と した。合成例3で示したように部分反応物Bは本発明の (C) 成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有し ている。このものを、2枚のガラス板に0.5mm厚み のシリコーンゴムシートをスペーサーとしてはさみこん で作成したセルに流し、80℃/60分、100℃/6 0分、120℃/60分加熱を行いほぼ無色透明のシー ト状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タック を有しないものであった。

【0153】(測定例2)実施例9で作成した硬化物 を、スガ試験機製のSX120型キセノンウェザーメー ター(ブラックパネル温度63℃、照射2時間中降雨1 8分)にて70時間照射して硬化物が着色するかどうか を調べたところ、着色がみられず無色透明の状態を保っ た。本発明の組成物は優れた耐光性を有している。

【0154】(実施例10)実施例9のようにして作成 したシート状硬化物を適当な形状に切断し、キャンタイ プ用の金属キャップに設けた光透過用窓の部分に固定す る。一方で、MOCVD(有機金属気相成長)法により サファイア基板上に形成した、SiとZnがドープされ たInGaN活性層をn型とp型のAlGaNクラッド 層で挟んだダブルヘテロ構造の発光素子を用意する。続 いて、この発光素子をキャンタイプ用の金属のステムに 載置した後、p電極、n電極をそれぞれのリードにAu 10 線でワイヤーボンディングする。これを上記のキャンタ イブ用の金属キャップで気密封止する。この様にしてキ ャンタイプの発光ダイオードを作成することができる。 【0155】(実施例11)洗浄したサファイア基板上 にMOCVD(有機金属気相成長)法により、アンドー プの窒化物半導体であるn型GaN層、Siドープのn 型電極が形成されn型コンタクト層となるGaN層、ア ンドープの窒化物半導体であるn型GaN層、次に発光 層を構成するバリア層となるGaN層、井戸層を構成す るInGaN層、バリア層となるGaN層(量子井戸構 してAIGaN層、Mgがドープされたp型コンタクト 層であるGaN屠を順次積層させる。エッチングにより サファイア基板上の窒化物半導体に同一面側で、pn各 コンタクト層表面を露出させる。各コンタクト層上に、 スパッタリング法を用いてAlを蒸着し、正負各電極を それぞれ形成させる。出来上がった半導体ウエハーをス クライブラインを引いた後、外力により分割させ発光素 子を形成させる。

【0156】表面に銀でメッキされた鉄入り銅から構成 されるマウントリードのカップ底面上に、ダイボンド樹 脂としてエポキシ樹脂組成物を利用して上記発光素子を ダイボンドする。これを170℃で75分加熱しエポキ シ樹脂組成物を硬化させ発光素子を固定する。次に、発 光素子の正負各電極と、マウントリード及びインナーリ ードとをAu線によりワイヤーボンディングさせ電気的

【0157】実施例9と同様にして調製した組成物を砲 弾型の型枠であるキャスティングケース内に注入させ る。上記の発光素子がカップ内に配置されたマウントリ ード及びインナーリードの一部をキャスティングケース 内に挿入し100℃1時間の初期硬化を行う。キャステ ィングケースから発光ダイオードを抜き出し、窒素雰囲 気下において120℃1時間で硬化を行う。これにより 砲弾型等のランプタイプの発光ダイオードを作成するこ とができる。

【0158】(実施例12)実施例11に記載の方法で 組成物および発光素子を作成する。

【0159】エッチングにより一対の銅箔パターンをガ ラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード 50 電極を持った基板を形成する。発光素子をエポキシ樹脂

を用いてガラスエポキシ樹脂上にダイボンドする。発光 素子の各電極と、各リード電極とをそれぞれAu線でワ イヤボンディングし電気的導通を取る。基板上にマスク 兼側壁として貫通孔があいたガラスエポキシ樹脂をエポ キシ樹脂により固定配置させる。との状態で真空装置内 に配置させると共に発光素子が配置されたガラスエポキ シ樹脂基板上に組成物をディスペンスし、貫通孔を利用 したキャビティ内に組成物を充填する。この状態で、1 00℃1時間、さらに150℃1時間硬化させる。各発 光ダイオードチップどとに分割させることでチップタイ 10 プ発光ダイオードを作成することができる。

【0160】(実施例13)実施例11に記載の方法で 組成物および発光素子を作成する。

【0161】インサート成形によりPPS樹脂を用いて チップタイプ発光ダイオードのパッケージを形成させる る。パッケージ内は、発光素子が配される開口部を備 え、銀メッキした銅板を外部電極として配置させる。パ ッケージ内部で発光素子をエポキシ樹脂を用いてダイボ ンドして固定する。導電性ワイヤーであるAu線を発光 素子の各電極とバッケージに設けられた各外部電極とに 20 それぞれワイヤーボンディングし電気的に接続させる。 パッケージ開口部内にモールド部材として組成物を充填 する。この状態で、100℃1時間、さらに150℃1 時間硬化させる。この様にして、チップタイプ発光ダイ オードを作成することができる。

【0162】(実施例14)実施例11に記載の方法で 組成物および発光素子を作成する。

【0163】組成物を90℃30分加熱してBステージ 化する。

【0164】エッチングにより一対の銅箔パターンをガ 30 ラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード 電極を持った基板を形成する。発光素子をエポキシ樹脂 を用いてガラスエポキシ樹脂上にダイボンドする。発光 素子の各電極と、各リード電極とをそれぞれAu線でワ イヤボンディングし電気的導通を取る。上記Bステージ 化した組成物を用いてトランスファー成形により発光素 子およびリード電極の一部を封止する。SMDタイプの 発光ダイオードを作成することができる。

【0165】(実施例15)実施例10と同様に順次積 層された窒化物半導体において、RIE(反応性イオン エッチング) 装置で p 型窒化物半導体層側からエッチン グを行い、負電極が形成されるn型コンタクト層の表面 を露出させる。次に、最上層にあるp型コンタクト層上 のほぼ全面にリフトオフ法によりNi/Auを膜厚60 /200Aにて積層し、オーミック接触が良好で且つ優 れた透過性を有する第一の正電極を形成する。また、上 記透光性第一の正電極上の一部にAuを膜厚1μm積層 し、正極側ボンディング部となる第二の正電極を形成す る。

ンタクト層の表面にそれぞれターゲットを変えてスパッ タリングによりW/A1/W/Auを膜厚200A/2. 000A/2000A/3000Aとなるよう積層し、 不要なレジスト膜を除去させ負電極を形成し、LED素 子とする。これにより、アニーリングを行わなくとも良 好なオーミック接触を有する負電極が形成される。ま た、負電極はボンディング部となるが、上記構成により 強い機械的強度を有するため、安定して駆動することが 可能なLED素子が得られる。

【0167】次に、パターニングにより、各電極のボン ディング部のみを露出させ索子表面全体に接してSiO 2 からなる絶縁性無機化合物層を連続的に形成し、LE D素子とする。上記絶縁性無機化合物層は少なくとも短 絡を防止できるように形成されていればよく、 上記正電 極と上記負電極の間の半導体層上面に設けられていれば よい。このように絶縁性無機化合物層を設けることは、 小型化された発光素子を信頼性高く実装するにあたり非 常に重要である。絶縁性無機化合物層の材料は、少なく とも絶縁性であれば良く、例えばSiO。、TiO。 Al2Os、SisN。等からなる単層又は複数層を用 いることができる。

【0168】また、本実施例では、上記絶縁性無機化合 物層を発光素子の端面まで連続して設けている。これに より、基板の削られた端面及び露出面を高温高湿から保 護することができ、厳しい環境条件下での長期間使用に 際しても高い信頼性を維持することが可能な発光素子が 得られる。また、サファイア基板や窒化ガリウムと直接 接して設けられる絶縁性無機化合物層は、それぞれ接す る部材と近い熱膨張係数を有することが好ましく、これ により更に信頼性を高めることができる。ちなみに、各 材料の熱膨張係数は、サファイア基板が7.5~8.5 ×10- 6/k、窒化ガリウムが3.2~5.6×10 - ⁸ /k、二酸化珪素が0.3~0.5×10⁻⁸ / k、窒化シリコンが2.5~3.0×10- 1/kであ る。

【0169】本実施例で使用する発光素子は、発光層で 発光された光の多くは上下の層との境界面にて全反射さ れ、発光端部から光密度高く発光する傾向にある。この ような発光素子を直接樹脂にて被覆すると、これらに発 光素子からの光や熱が集中するため、隣接する樹脂部が 局所的に著しく劣化される。これが起因となり、発光ダ イオードに色調変化や信頼性低下が生じると考えられ る。そこで本実施例では、絶縁性無機化合物層を表面に 有する発光素子を、上記絶縁性無機化合物層と比較的密 着性が高い傾向にあり且つ耐光性及び耐熱性に優れた本 発明の組成物にて直接被覆することにより、上記発光領 域端部から発光される光を効率よく外部へ取り出し、界 面における劣化を抑制し、信頼性の高い発光装置を提供 する。

【0166】一方、エッチングにより露出されたn型コ 50 【0170】また、上記発光端部とは、発光層及びn型

コンタクト層端部を示す。そこで、これらの端部に設けられる絶縁性無機化合物層は、n型コンタクト層としてよく用いられるGaNよりも屈折率が小さい無機物にて構成することが好ましい。これにより、組成物の劣化を抑制することができる。更に、前記絶縁性無機化合物を、例えば、発光素子の発光端部に直接接する第一の層としてSiO2を、該第一の層に接して該第一の層よりも屈折率の大きい第二の層としてTiO2を積層したTiO2/SiO2や、TiO2/MgF2等の2層構造や、SiO2/Al/SiO2のように絶縁膜と金属の10積層によって形成した3層構造からなる光学多層膜を設けることにより、反射性を持たせることもできる。複数層の場合、膜厚は5000A以上5μm以下が好ましく、1μm以上3μm以下がより好ましい。

【0171】また、本実施例のように、発光素子の表面 に無機化合物層を設け、該無機化合物層上に接して本発 明の組成物にて封止材を形成する場合、前記無機化合物 層と前記封止材との光屈折率差、熱膨張係数差、及び各 界面の密着性を考慮し、前記無機化合物層は本発明の組 成物の必須成分(D)の一部である金属原子及び/又は 20 半金属原子と共通の原子を有することが好ましい。これ により光取り出し効率および信頼性を向上させることが できる。さらに、上記共通原子としてケイ素を選択する と、他の原子を共通原子として選択した場合と比較し て、高温高湿等の環境条件下においても高い信頼性及び 光学特性を維持することができる傾向にある。この理由 は定かでないが、本発明の組成物の必須成分(A)とケ イ素を有する物質とは、何らかの作用により親和性が良 く、これらの界面は密着性が高いと考えられ、これによ り水分や外気の侵入が抑制されているためだと考えられ 30 る。珪素を含有する無機化合物層とは、前記無機化合物 中に少なくとも珪素が含有されていれば特に限定されて ず、具体的には、SiO₂、SiN、SiON、及びS iH、等からなる無機化合物層が挙げられる。

【0172】上記のように形成されたLED素子を有するウェハをスクライブ可能な基板厚まで研磨工程によって削り、基板面が粘着シートに接触するように粘着シート上に載置し、スクライブ工程によってチップ状に分割する。分割されたLEDチップを実施例13と同様のパッケージ内部に同様の方法にて固定し、Au線によりワイヤーボンディングさせ電気的に接続させる。

【0173】次に、実施例9と同様にして調製された組成物を、上記パッケージ内部に注入する。注入後、100℃1時間+150℃1時間硬化させ封止材とし、チップタイプ発光ダイオードを形成する。

【0174】このようにして形成された発光ダイオードは、優れた耐熱性且つ強靱性を有する封止材にて構成されているため、実装時や点灯時の熱応力による樹脂及び発光素子におけるクラック発生やワイヤ断線を防止することができる。

【0175】また、このようにして得られた封止材には、(D)成分の加水分解縮合反応によって、微粒子の集合体からなる非結晶性金属酸化物及び/又は非結晶性半金属酸化物が分散している。上記微粒子集合体は、高純度で且つ高い透明性を有しているため、光取り出し効率を妨げることなく封止材の線膨脹係数を小さくすることができる。これにより、信頼性向上と光学的性能の維持の両立を実現することが可能な発光ダイオードを得ることができる。

【0176】このように本発明の発光ダイオードは、優れた耐熱性を有しているため、Pbを有していない、高融点値を有する導電部材にて実装しても、色度変動や信頼性低下を生じず、環境に優しい表示装置を実現することができる。

【0177】また、本発明の封止材は、熱応力における 柔軟性を有する硬化物である。従来、熱応力に柔軟性を 有する樹脂として、ゴム状弾性樹脂、ゲル樹脂等が知ら れているが、これらの樹脂は架橋密度が低い又は架橋構 造を有さないので機械的強度が弱く、またタック性を有 するため異物が付着しやすい等の問題点を有しており、 最表面部となる発光面として形成するには不向きであっ た。これに対し本発明の組成物は、異物を付着したり実 装用器具にて損傷を受ける恐れがない。このように本発 明は、本発明の組成物を用いることにより、発光素子及 びワイヤ部分の被覆部材と発光装置の表面部となる発光 面の部材を一体成形することができ、量産性及び作業性 に優れた発光ダイオードを得ることができる。また、太 陽光に対しても優れた耐光性を有するため、屋外用表示 基板に実装されても発光面は変色されず良好な信頼性を 維持することができる。

【0178】本発明では、各構成部材に無機蛍光物質や 有機蛍光物質等、種々の蛍光物質を含有させることが出 来る。このような蛍光物質の一例として、無機蛍光体で ある希土類元素を含有する蛍光体がある。希土類元素含 有蛍光体として、具体的には、Y、Lu、Sc、La、 Gd及びSmの群から選択される少なくとも1つの元素 と、A1、Ga、及びInの群から選択される少なくと も1つの元素とを有するざくろ石型蛍光体が挙げられ る。特にセリウムで付活されたイットリウム・アルミニ ウム酸化物系蛍光体が好ましく、所望に応じてCeに加 えてb、Cu、Ag、Au、Fe、Cr、Nd、Dy、 Ni、Ti、Eu、及びPr等を含有させることも可能 である。また、本発明の組成物に、上記発光素子の光の 一部を吸収し他の波長の光を発光することが可能で且つ 表面に上記組成物と共通な無機元素を含有する物質がコー ーティングされた無機蛍光物質を添加すると、これらの 界面は化学結合等により良好な密着性を有する傾向にあ る。また、上記蛍光物質は上記構成とすることにより上 記組成物中にて良好に分散した状態で固着される。とれ 50 により、上記無機蛍光物質の光吸収率及び光取り出し効

率が向上され高輝度で均一に発光することが可能な色変 換型発光ダイオードが得られる。

【0179】(実施例16)実施例13と同様の方法に て、バッケージ内に発光素子を載置しワイヤにて電気的 接続を取る。ここでバッケージの開口部を除く表面にレ ジスト膜を形成する。このようにLEDチップが載置さ れたパッケージを純水が入った容器内に配置させる。

【0180】他方、粒子状蛍光体は、Y、Gd、Ceの 希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で 共沈させる。これを焼成して得られる共沈酸化物と、酸 10 化アルミニウムと混合して混合原料を得る。これにフラ ックスとしてフッ化アルミニウムを混合して坩堝に詰 め、弱遠元雰囲気中および遠元雰囲気中にて1400℃ の温度で3時間焼成して焼成品を得る。焼成品を水中で ボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に篩を通して (Yo. a Gdo. 2) a Ala O, 2: Ce蛍光体を 形成する。とうして得られた蛍光物質をSiO2ゾル中 に分散させてなる混合溶液を形成する。

【0181】次に、酢酸でpHを5.0に調整した後、 直ちにパッケージが配置された容器中に上記混合溶液を 20 ダイオードが得られる。 一挙に注入する。静置後(Y。.。Gd。.2)。Al 5 O 1 2 : C e 蛍光体はパッケージの開口部及び発光素 子上に沈降する。容器内の廃液を除去しLEDチップト に粒子状蛍光体が堆積したパッケージを120℃で乾燥 させる。

【0182】次に、容器から発光ダイオードを取り出し*

* て発光ダイオードの非発光部に付着した粒子状蛍光体を レジストマスクごと除去する。こうして得られた発光ダ イオードは、LEDチップ上とパッケージ底面との膜厚 が共に約40μmと略等しい無機化合物層を有する。 さ らに、LEDチップや粒子状蛍光体を外部応力、太陽 光、水分及び塵埃などから保護する目的で、無機化合物 層が形成されたパッケージ内にモールド部材として実施 例9と同様に調製された組成物を充填し封止部材を形成

44

【0183】とうして得られた発光ダイオードは、耐久 性に優れ且つ他の部材との線膨張係数差が緩和された封 止部材にて構成されているため、厳しい環境下での使用 や長時間の使用に際しても色ズレや色むらが生じること なく、優れた信頼性を有している。

【0184】 (実施例17) ダイボンド樹脂として本発 明の組成物を利用する以外は、実施例10と同様にして 発光ダイオードを形成する。このように構成することに より、発光素子の周囲の部材を全て耐熱性及び耐光性に 優れた組成物とすることができ、更に信頼性の高い発光

 $\{0185\}$

【発明の効果】本発明の組成物から製造した材料は、光 劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さらに光学的透明 性が高く、かつ、硬質であり表面タック性を有さない光 学材料用に適した材料である。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

HO1L 33/00

(72)発明者 津村 学

大阪府摂津市鳥飼西5丁目2-23浩然寮A

(72)発明者 坂本 晴美

大阪府摂津市鳥飼和道1丁目8-28サニー コート 401号室

(72)発明者 藤田 雅幸

大阪府摂津市鳥飼西5丁目5-32-102

(72)発明者 蔵本 雅史

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内

FΙ

HO1L 33/00

・マコード(参考)

N

(72)発明者 三木 倫英

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内

Fターム(参考) 4J002 BG041 BL011 CC041 CF001

CF161 CG001 CH001 CL001

CM041 DA117 DD078 DE197

EC078 EX006 EX038 EX049

FD157 GP00

5F041 AA34 AA44 CA04 CA05 CA34

CA40 CA46 CA65 DA16 DA19

DA33 DA34 DA45 DA73 DA76

DB01 DB06 DB09